# フェムト秒レーザーによるナノ薄膜加工と高品質な電子位相 ホログラムの実現

東北大学 多元物質科学研究所 助教 上杉 祐貴 (2019 年度 一般研究開発助成 AF-2019203-B2)

キーワード:フェムト秒レーザー、レーザー干渉加工、薄膜、電子位相ホログラム

## 1. 研究の目的と背景

1980年代にチャープパルス増幅法<sup>1)</sup>が開発されて以降, 高いピークパワーを有するピコ秒~フェムト秒の超短パ ルスレーザーが実用化され,それに伴い様々な材料加工・ 改質技術が実現された.近年では,それらの先端技術が産 業的にも普及し始め,レーザーアブレーションによる高品 質な機械加工や,材料表面にナノ周期構造を形成して撥 水・親水性を付与する表面改質技術などが登場している.

超短パルスレーザーによる加工は、従来用いられてきた 大出力の連続レーザーやナノ秒レーザーによる材料加工 技術とは異なる、いくつかの優れた特性を有している.レ ーザーパルスの持続時間が材料の熱伝導や格子振動の時 間スケールと同じ程度か、それより短時間であるため、材 料を構成する原子を瞬時にプラズマ化して除去する、レー ザーアブレーションを引き起こす.これにより、材料加工 における熱影響部やリキャスト層およびクラックの発生 を最小化することができ、優れた加工品質を実現できる.

超短パルスレーザーのもう一つの特徴は,その非常に高 いピークパワーに起因して、材料とレーザー光の間に非線 形な相互作用が生じる点である.通常であれば、材料物質 が吸収しない低エネルギーの光子(長波長の光)であって も,多光子励起過程による各種反応が生じ,材料を加工す ることが可能である. 例えば、波長 800-1100 nm 程度の超 短パルスレーザーを,高い開口数 (NA) をもつ対物レンズ でガラスの内部に集光すると、光の密度が高い焦点付近の 小領域でのみ, 選択的に加工を行うことができる. 多光子 励起過程が生じる領域とそれよりも光密度が低い領域と の境界は、光強度に応じてしきい値的に現れ、結果として レーザー波長よりもずいぶん小さな 100 nm 以下の加工分 解能を達成することができる<sup>2,3)</sup>.以上に述べたレーザー アブレーション加工の特徴を要約すると次のようになる. 1) 材料に対する負荷が小さい高品質な加工が得られる. 2) 非線形性を利用してナノスケール分解能が得られる.

レーザー光に対して不透明な金属や半導体などの材料 に対する加工現象の研究は,超短パルスレーザーが普及す る 1990 年代から多くの研究者によって実施されてきた. その多くは実用性の観点から,ある程度の厚さのあるバル ク材に深穴や切断加工を施するような用途が主であり,材 料内部にレーザーの集光スポットを形成することが出来 ないこれらの材料では,達成される加工分解能は 10µm 程 度であった.つまり,2の特徴は非透明材料に対してはほ とんど期待されないのが普通である.しかい,もし材料の 厚さが集光したレーザーの焦点深度よりも十分に小さい 場合には,どのような加工結果が得られるだろうか?

筆者らは初め、電子顕微鏡法の分野で用いられる透過型 電子位相ホログラムを作製することを目的に、レーザーア ブレーションによる薄膜加工技術の開発に取り組んだ<sup>4)</sup>. このホログラムは、電子ビームの透過損失を最小に抑えつ つ、空間位相変調作用を与えて電子ビームの波面を操作す るために、厚さがわずか数 10 nm 材料で作製する必要があ った. 具体的には、電子の加速電圧が 200 kV の場合、電 子ビームに位相差πを与えるのに必要なシリコン (Si) お よび窒化シリコン (SiN) の厚さは、それぞれ 36 nm と 26 nm である. さらに、このホログラムは支持基板なしに真 空中で自立した形状をとる必要があった.

電子顕微鏡用のホログラムや回折格子などの電子光学 素子は、ナノスケール分解能の精度が要求されるため、一 般に集束イオンビーム(FIB)を用いて作製されることが 多い.しかし、高エネルギー(1-50 keV)のイオンビーム 照射は、材料に無視できない程の機械的ストレスを与える. そのため、厚さが100 nmに迫るような薄膜材料の加工に おいては、試料にダメージを与えずに目標の構造を作製す るのは、非常に大きな技術的困難を伴うことになる.

ここで,筆者らが開発し採用したレーザーアブレーショ ン加工法と従来の FIB 法による薄膜加工とを比較すると, 以下のような利点があることが分かる.まず,光パルス自 体が試料に与える圧力(光圧)は無視できるほど小さいた め,ナノメートルの厚さの薄膜材料であってもダメージを 与えることなく加工することができる.次に,2本のレー ザービームを試料表面上で干渉することで,レーザー干渉 縞によるホログラフィックパターンを,試料面上に焼き付 けるようにアブレーション加工することができる.つまり, 入射レーザーのビームサイズに対応した面積を,シングル ショットで加工することが可能であり,FIBの描画加工に 比べて圧倒的に高速の加工が実現される.また最後に,レ ーザー加工は大気中で施すことができるため,試料準備や 加工を手軽に実施することができるのも特徴である.

レーザーアブレーションを駆使した本薄膜加工法は, FIB 法などの従来の微細加工技術では取り扱えない薄い 材料—「ナノ薄膜」—を加工可能な唯一の手法であるとい える.そのため、本技術の高度化を図り、微細加工技術と して確立することができれば、基礎科学はもとより将来の 産業応用にも幅広い貢献が期待できる.これを達成するた めに本研究では、「レーザー干渉加工の高分解・高解像化」、

「薄膜に対するアブレーション加工条件の系統的な調査」, 「高 NA 対物レンズを使った微細穴あけ加工試験」に取り 組んだ.その成果について,本論文において順に結果を示 す.また,論文の最後において本研究のまとめと将来展望 について述べる.

## 2. 電子ホログラムの高解像化

電子顕微鏡法の分野では、2010年代から電子渦と呼ば れる螺旋状の等位相面を有する電子ビームの研究が着目 されるようになった<sup>5,6)</sup>.電子渦は軌道角運動量を有する ユニークな電子ビームであり、軌道-スピン角運動量間の 相互作用を通じて、材料のもつキラル性や表面上のトポロ ジカルな構造を計測するプローブとして利用が期待され ている.電子渦を発生するには、ビーム軸中央に位相特異 点構造をもった、フォーク状の電子ホログラムを用いるの が一般的である.筆者らはこれまでに、厚さ35 nmのSi 薄膜を用いて、軌道角運動量 $m = \pm 1$ の電子渦を高効率で 発生可能な電子位相ホログラムの開発に成功した<sup>4)</sup>.その 後、 $m = \pm 2$ の高次電子渦を発生するホログラムの作製に 取り組んだが、位相特異点を再現するためのホログラム中 央のフォーク状構造を、解像度よく作製することができず に、電子渦の発生効率が著しく低下してしまった.

作製した*m* = ±1および*m* = ±2のホログラムの様子と, これらのホログラムを使って電子顕微鏡内で発生した電 子渦のビームプロファイルを,それぞれ図1に示す.透過 電子顕微鏡 (TEM)の明視野像において,ホログラム中央の 直径8 µmの領域が照明されている.*m* = ±2のホログラム では,照明された領域の大部分で加工が施されていないの がわかる.これは,加工に用いたレーザー干渉縞が中央部 分で不明瞭であったことが原因である.得られた電子回折 像では,それぞれ主に3つのビームプロファイルが観測さ れた.中央のプロファイルは,入射電子ビームがそのまま 透過したもの(0次回折)を示しており,その両側に±1お よび±2次の回折ビームが現れ,これが電子渦である.±2 次の回折ビームは発生効率が低いうえに,プロアイル形状 が歪んでおり,電子渦を発生するにあたってホログラムの 性能が十分ではないことがわかる.

ホログラムの性能を改善するためには、回折格子の間隔 をより密にし、かつ中央部分まで分解能良くフォーク構造 を形成する必要がある.そのために、加工に利用するレー ザー干渉縞を明瞭かつ高解像化するための光学系の改良 に取り組んだ.図2に構築した光学系の概念図を示す.ま ず、レーザー波長を第二高調波発生(SGH)によって、レ ーザー光源出力の1040 nmから520 nmに変換した.これ により、形成される干渉縞の間隔を半分にすることができ る.次に、入射レーザーにホログラム波面を付与するのに 使用する空間光変調器(SLM)面上において、レーザーの ビーム直径を2 nmから10 nmに拡大した.これに合わせ て、SLMから試料表面までの1枚の凸レンズと対物レンズ とからなる縮小投影系の倍率を、1/75 から1/250 に変更 した.これにより、試料表面上に形成される干渉縞パター ンの解像度を向上することができる.

改良した光学系を用いて作成したm = ±2のホログラム を,以前に作製したものと同じ縮尺で並べた様子を図3に 示す.フォーク構造の中央部分の未加工領域が狙い通り減 少していることが確認できる.また回折格子の間隔がおよ そ半分になっている様子もわかる.このように,光学系の 結像倍率やレーザー波長などのパラメータを最適化する ことで,より高品質な電子位相ホログラムを作製できるこ とが確認できた.

# 3. 薄膜アブレーション加工条件の系統調査

前節の結果で達成されたホログラムの格子間隔は 740 nm であった.これは入射レーザーの波長と2 ビームの交 差角度で決定する干渉縞間隔そのものであり,光学設計で 決まる制約である.一方で,図3の結果を見ると格子間隔



図 1. 作製したm=1およびm=2のフォーク状電子位相ホログラム. 左から光学顕微鏡および走査電子顕微鏡による, ホログラムの表面観察の結果を示す. ホログラムの直径はともに約 30 µm であった. TEM 像とあるのは, ホログラムを 電子渦発生用の透過電子顕微鏡にインストールし取得した明視野像. 電子ビームはホログラムの中央の直径約 8 µm の領 域を照明している. 電子回折像は同じ電子ビームの照射条件で取得した. この図中の赤破線上の電子強度分布を, ライ ンプロファイルとして一番右に示した.



図 2. 本研究において開発した波長 520 nm のレーザー干 渉加工光学系.詳細については本文および文献 7 を参照さ れたい.



図 3. 過去に作製した**m** = ±2の電子位相ホログラムと本 研究で新たに作製したホログラムの比較. 左図は図1に示 した画像を比較のために再掲したもの.

740 nm のうちスリット幅と格子幅が均等に分配されてい るわけではなく、かなり細い格子構造が実現していること がわかる. レーザー加工の条件を変えることで格子幅を 100 nm 以下に制御したり、逆にスリット幅を狭く制御す ることは可能であろうか?この疑問に答え本技法の加工 分解能の限界を調査するために、様々な加工パラメータで 系統的な薄膜加工を実施した.

図4に、様々な入射レーザーパルスエネルギで加工を施 した厚さ10 nmのSiN薄膜のSEM像を示す.2本の入射レ ーザービームは共に平面波状であり、実現した加工構造は ストライプ状の複スリットになった.この結果から、照射 パルスエネルギーが大きくなるにつれて、形成されるスリ ット幅が系統的に大きくなる様子が確認できる.図中最大 の6.4 µJのパルスエネルギーを照射した際には格子がい くつか歪み割れてしまっている.これは、試料に用いた SiN膜が加工前にすでに歪み、波打った形状をしていたこ とが原因であったと考えられる.

得られた実験結果を現象論的に説明するために,照射レ ーザーの試料面上のフルーエンスF (J/cm<sup>2</sup>) と SiN 膜のア ブレーションしきい値の情報を用いて,図 5 に示す加工モ デルを提案した.材料には固有のレーザーアブレーション が生じるしきい値フルーエンスF<sub>th</sub>が存在する.試料表面 上に形成されたレーザーの強度分布のうち,そのしきい値 を超える領域では物質が取り除かれ,それ以外の場所では 一切の加工・損傷を受けない,という簡単な仮定を導入し た.これは本加工が入射レーザー強度に対して非線形な現



図4. 異なる入射パルスエネルギーで干渉加工した厚さ10 nm の SiN 薄膜の SEM 像. 左上に示した値はそれぞれの加 工における入射パルスエネルギー. スケールバーは左列が3 µm であり,右列が500 nm である.

象であることを示している. これに従うと, 入射レーザー のパルスエネルギーを調整することで, 原理的には無限小 さなスリット幅から格子間隔である 740 nm いっぱいのス リット幅まで制御できることになる. 実際の実験結果では もちろん有限のスリット幅および格子幅が観測され, その 最小値はスリット幅において 113 nm, 格子幅において 43 nm という結果を得た.

この実験によって,薄膜のレーザーアブレーション加工 において加工形状を決定する主要なパラメータは,材料固 有のしきい値フルーエンスと,入射レーザーの試料面上で の強度分布の2つのみであることが分かった.そして,し きい値近傍に調整した入射レーザーパルスを用いること で、100 nmに迫る加工分解能が得られることを示された。



#### スリット状に加工された薄膜

図 5. 入射パルスエネルギーに応じて格子幅およびスリット幅が変化する原理. (a)本光学系におけるレーザー入射 条件を単純化したモデル. (b)試料表面上のレーザーフル ーエンスFと材料のしきい値フルーエンスFthの関係. 横軸 は干渉縞に垂直な面上の1方向を示す.

### 4. 微細穴あけ加工試験

2本のフェムト秒レーザーによる干渉加工実験では、レ ーザー波長 520 nm に対して 1/5 の大きさの微細構造を作 製することができた.これは、超短パルスレーザーを使用 したレーザー加工特有の非線形性によるものである.透明 材料に超短パルスレーザーを強く集光して照射すると、 100 nm 以下の高い空間分解能の加工が実現できるように、 非透明材料についても、それがナノ薄膜であれば非常に高 い加工分解能を達成できることが示唆される.

薄膜レーザー加工で達成可能な空間分解能を調査する ために,波長1040 nmのフェムト秒レーザー1本をNA=0.95 の光学顕微鏡用対物レンズで集光する加工系を用意して, 微小穴あけ加工の試験を行った.レーザー光は対物レンズ 瞳の大きさに等しいフラットトップな強度分布で対物レ ンズに入射する.焦点におけるレーザーのスポット径は回 折限界に近い~500 nmであった.このような高NA下の集 光では,スポット形状が偏光の向きに依存することが知ら れているため,入射レーザーは円偏光にして使用した.

レーザーの入射パルスエネルギーを変えながら厚さ 10 nmのSiN 膜に加工を行った結果を図6に示す.入射レー ザーのピークフルーエンスが加工のしきい値に最も近い 条件で,直径約100 nmの微細穴あけ加工を達成した.こ の直径はレーザー波長の実に1/10の大きさであり,回折 限界のスポット径よりもさらに小さな加工穴を実現する ことが出来た.照射レーザーのスポット径は波長に比例す るため,本結果を単純に外挿すると,倍波の波長520 nm のフェムト秒レーザーを使用すれば52 nmの穴あけ加工 が,さらに倍波をとって260 nmのフェムト秒レーザーと すれば,26 nmというFIBに迫る微細穴あけ加工が実現す ると期待できる.

もちろん,実際にはレーザー波長が短くなると多光子励 起過程が生じなくなるから,上記のような単純な外挿は適 用できないだろう.一方で,先端の光学研究では,対物レ ンズに入射するレーザーの強度分布や位相分布および偏 光分布を制御することで,単純な開口回折の限界を超えた



図 6. 高NAの対物レンズで集光した近赤外レーザーによる微細穴あけ加工.各パルスエネルギーの条件ごとに3回加工を施している.

超分解能の光スポット形成を達成する手法が複数提案されている.そのような高度に構造化されたレーザービーム を利用することで,波長を変えなくとも加工分解能の向上 を図ることができる可能性もあり,今後も調査を続ける必 要があるだろう.

## 5. まとめ

超短パルスレーザーを使ったレーザーアブレーション 加工は、FIB法などの従来の微細加工手法では加工するこ とが困難であった、厚さ100 nm以下のナノ薄膜を容易に 加工できる唯一の手法である.本研究において、薄膜レー ザー加工法の進展に取り組み、以下の成果を得た.

まず、2本のフェムト秒レーザーを試料表面上で干渉さ せるレーザー干渉加工の手法において、使用するレーザー 波長を1040 nmから520 nmへ短波長化しつつ、結像光学 系の縮小倍率を最適化することで、光の集光限界を大幅に 超える高分解能・高解像度の微細加工を達成した.次に、 レーザーの入射パルスエネルギーを調整して試料表面上 のフルーエンスを制御することで、得られる薄膜の加工形 状を任意に制御できることを見出した.また、近赤外域波 長のレーザー光を1本のみ、高NAの対物レンズで強く集 光することによって、波長の1/10の直径(100 nm)の微 細穴あけ加工を達成した.扱う薄膜試料の厚さも10 nmに まで達した.加工パラメータを適切に調整することで、比 較的広い入射パルスエネルギーの範囲で、ダメージのない 薄膜加工を実現することが出来た.

本研究により,非透明材料のナノ薄膜加工においては, 透明材料の超短パルスレーザー加工と同様に,非線形性を 利用したナノスケールに高い空間分解能が得られること が示された.本レーザー加工技術は,FIB等の既存のナノ 加工技術が不得意とした材料の取り扱いを補完すること ができる,唯一無二の材料エンジニアリングの手法である と言える.先端の電子顕微鏡法研究で要求される電子ホロ グラムなどの素子に加えて,微細化の進む先端半導体産業 やグラフェンなどの二次元結晶材料を用いる量子科学研 究においても,将来的な応用展開が期待される新しい要素 技術であるといえる.

# 謝 辞

電子渦発生実験において名古屋大学の齋藤晃先生に多 大なご支援をいただきました.レーザー加工光学系の設計 および構築にあたり東北大学の小澤祐市先生と佐藤俊一 先生に多くのアドバイスをいただきました.

# 参考文献

- The Nobel Prize in Physics 2018, Nobel Foundation. Retrieved, 2 October 2018.
- M. K. Bhuyan *et al.*, Appl. Phys. Lett. 97, 081102 (2010).
- 3) A. Rodenas *et al.*, Nat. Photonics **13**, 105 (2019).

- Y. Uesugi, R. Fukushima, K. Saitoh and S. Sato, Opt. Express 27, 20958 (2019).
- 5) M. Uchida and A. Tonomura, Nature **464**, 737 (2010).
- J. Verbeeck, H. Tian, and P. Schattschneider, Nature 467, 301 (2010).
- Y. Uesugi, R. Fukushima, Y. Kozawa and S. Sato, Opt. Express 28, 26200 (2020).